

Présentation

Code interne : EEL9-MICR2

Description

Cette formation d'une semaine sur le site de l'AIME donne une approche complète, théorique et pratique, sur les opérations fondamentales de fabrication des circuits intégrés silicium en technologie NMOS, depuis la réception du substrat de silicium jusqu' à la mise en boîtier du composant final et sa caractérisation électrique. Parallèlement, il est procédé à la caractérisation physique des différentes étapes de fabrication.

Le stage se déroule en salle blanche à l'AIME de Toulouse (Atelier Interuniversitaire de Micro-nano-Electronique), pôle CNFM de Toulouse) et fait appel à des moyens matériels lourds.

Heures d'enseignement

TI	Travaux Individuels	12h
TD	Travaux Dirigés	30h

Syllabus

Oxydation du Wafer
Gravure et diffusion des zones actives
Dépôt et gravure du polysilicium de grille
Ouverture des contacts
Métallisation
Test sous pointes
Mise en boîtier
Caractérisation électrique

Modalités de contrôle des connaissances

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves

Type d'évaluation	Nature de l'épreuve	Durée (en minutes)	Nombre d'épreuves	Coefficient de l'épreuve	Note éliminatoire de l'épreuve	Remarques
Contrôle Continu Intégral	Contrôle Continu			2		

Infos pratiques

Contacts

Eric Kerherve

✉ Eric.Kerherve@bordeaux-inp.fr

Yann Deval

✉ Yann.Deval@bordeaux-inp.fr